

КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Е

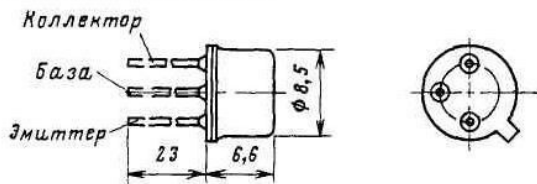
Транзисторы кремниевые планарные *n-p-n* усилительные высоко-частотные

Предназначены для усилительных и импульсных схем

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса

Масса транзистора не более 2 г



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 150$ мА

при $T = 298$ К

| | |
|----------------|-----------|
| КТ630А | 40 - 120 |
| КТ630Б | 80 - 240 |
| КТ630В, КТ630Г | 40 - 120 |
| КТ630Д | 80 - 240 |
| КТ630Е | 160 - 480 |

при $T = 398$ К

| | |
|--------|----------|
| КТ630А | 40 - 240 |
| КТ630Б | 80 - 480 |

при $T = 213$ К

| | |
|--------|----------|
| КТ630А | 15 - 120 |
| КТ630Б | 30 - 240 |

Граничное напряжение при $I_3 = 100$ мА, $\tau_{и} \leq 300$ мкс, $Q \geq 200$ не менее

| | |
|----------------|-------|
| КТ630А | 90 В |
| КТ630Б | 80 В |
| КТ630В | 100 В |
| КТ630Г | 60 В |
| КТ630Д, КТ630Е | 50 В |

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА не более

| | |
|--|-------|
| | 0,3 В |
| | 1,1 В |

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА не более

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_K = 10$ В, $I_K = 60$ мА не менее

| | |
|--|--------|
| | 50 МГц |
| | 15 пФ |

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ0} = 10$ В не более

| | |
|--|----------|
| | 65 пФ |
| | 5 - 8 Ом |

Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала* при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 270$ Гц

Входное сопротивление в схеме с общим эмиттером в режиме малого сигнала при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 5$ мА, $f = 270$ Гц

| | |
|--|-----------------|
| | 200 - 1200 Ом |
| | 500* Ом |
| | 0,04 - 0,25 мкс |
| | 0,1* мкс |

Время включения* при $I_K = 200$ мА, $I_B = 40$ мА, $\tau_{и} = 10$ мкс

Время выключения* при $I_K = 200$ мА, $I_B = 40$ мА, $\tau_{и} = 10$ мкс

| | |
|--|----------------|
| | 0,08 - 0,5 мкс |
| | 0,25* мкс |

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $I_K = 100$ мкА $R_{ЭБ} = 3$ кОм не менее:

| | |
|----------------|-------|
| КТ630А, КТ630Б | 120 В |
| КТ630В | 150 В |
| КТ630Г | 100 В |
| КТ630Д, КТ630Е | 60 В |

Постоянное напряжение база-эмиттер при $I_3 = 100$ мкА не менее:

| | |
|------------------------|-----|
| КТ630А, КТ630Б, КТ630В | 7 В |
| КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е | 5 В |

Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} = 3$ кОм КТ630А, КТ630В при $U_{КЭ} = 80$ В; КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е при $U_{КЭ} = 40$ В не более

| | |
|--|---------|
| | 1 мкА |
| | 0,1 мкА |

Пределы эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} = 3$ кОм:

| | |
|----------------|-------|
| КТ630А, КТ630Б | 120 В |
| КТ630В | 150 В |
| КТ630Г | 100 В |
| КТ630Д, КТ630Е | 60 В |

Постоянное напряжение коллектор-база:

| | |
|----------------|-------|
| КТ630А, КТ630Б | 120 В |
| КТ630В | 150 В |
| КТ630Г | 100 В |
| КТ630Д, КТ630Е | 60 В |

Постоянное напряжение эмиттер-база КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д

| | |
|--|-----|
| | 7 В |
|--|-----|

Постоянный ток коллектора КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е

| | |
|--|-----|
| | 1 А |
|--|-----|

Импульсный ток коллектора КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е

| | |
|--|-----|
| | 2 А |
|--|-----|

Постоянный ток базы КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е

| | |
|--|-------|
| | 0,2 А |
|--|-------|

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 233 - 298$ К КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е

| | |
|--|--------|
| | 0,8 Вт |
|--|--------|

при $T = 358$ К КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е

| | |
|--|--------|
| | 0,2 Вт |
|--|--------|

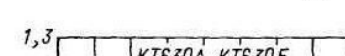
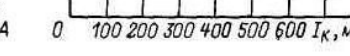
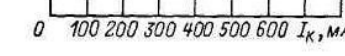
Температура перехода

| | |
|--|-------|
| | 398 К |
|--|-------|

Температура окружающей среды

| | |
|--|-----------------|
| | От 233 до 358 К |
|--|-----------------|

Примечание Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора при температуре не более 533 К в течение не более 3 с Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом изгиба 1,5-2 мм



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.